

КТ8164

высоковольтный биполярный
эпитаксиально-планарный
п-р-п транзистор

Назначение

Транзистор п-р-п кремниевый эпитаксиально-планарный в пластмассовом корпусе. Предназначен для использования в импульсных источниках питания, пускорегулирующих устройствах и другой радиоэлектронной аппаратуре, изготавливаемой для народного хозяйства

Зарубежные прототипы

- прототип - MJE13005, MJE13004

Номер технических условий

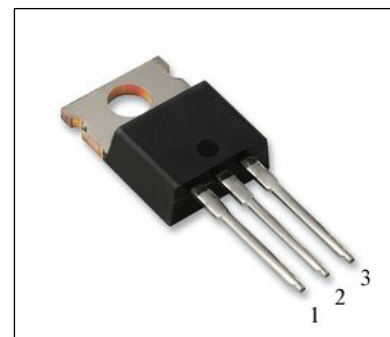
- АДБК. 432150.565 ТУ

Особенности

- диапазон рабочих температур от - 45 до + 100 °С

Корпусное исполнение

- пластмассовый корпус КТ-28 (ТО-220)

**Назначение выводов**

Вывод	Назначение
№1	База
№2	Коллектор
№3	Эмиттер

Таблица 1. Основные электрические параметры КТ8164 при $T_{\text{окр. среды}} = + 25\text{ }^{\circ}\text{C}$

Параметры	Обозначение	Ед. измер	Режимы измерения	Min	Max
Гр. напряжение коллектор-эмиттер КТ8164А КТ8164Б	* $U_{кэ\text{о гр.}}$	В	$I_{к}=10\text{ мА}, I_{б}=0,$	400 300	
Обратный ток коллектора КТ8164А КТ8164Б	$I_{кэ\text{о}}$	мкА	$U_{кэ}=400, I_{б}=0,$ $U_{кэ}=300, I_{б}=0$		3,0 3,0
Обратный ток коллектора	* $I_{к\text{б}\text{о}}$	мА	$U_{к\text{б}}=700\text{В}$ $U_{к\text{б}}=600\text{В}$		0,1 0,1
Обратный ток эмиттера	* $I_{э\text{б}\text{о}}$	мА	$U_{э\text{б}}=9\text{В},$		1,0
Статический коэффициент передачи тока	* $\beta_{21\text{E}}$		$U_{кэ}=5\text{В}, I_{к}=1,0\text{А}$ $U_{кэ}=5\text{В}, I_{к}=2,0\text{А}$	10 8	60 40
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер	* $U_{кэ(\text{нас})}$	В	$I_{к} = 1\text{А}, I_{б} = 0,2\text{А}$ $I_{к} = 2\text{А}, I_{б} = 0,5\text{А}$ $I_{к} = 4\text{А}, I_{б} = 1\text{А}$		0,5 0,6 1,0
Напряжение насыщения база-эмиттер	* $U_{бэ(\text{нас})}$	В	$I_{к} = 1\text{А}, I_{б} = 0,2\text{А}$ $I_{к} = 2\text{А}, I_{б} = 0,5\text{А}$		1,2 1,6
Время включения Время спада Время рассасывания	$t_{\text{вкл.}}$ $t_{\text{сп.}}$ $t_{\text{рас.}}$	мкс	$U_{кэ}= 125\text{В}, I_{к} = 2\text{А},$ $I_{б1}= I_{б2} = 0,4\text{А}$		0,8 0,9 4,0
Граничная частота коэф. передачи тока	$f_{\text{гр.}}$	МГц	$U_{кэ}=10\text{В}, I_{к}=0,5\text{А}$	4	
Емкость коллекторного перехода	$C_{\text{к}}$	пФ	$U_{к\text{б}}=10\text{В}, I_{э}=0,$ $f=1\text{МГц}$		110

* - $t_{\text{и}} \leq 300\text{мкс}, Q \geq 100$

Таблица 2. Значения предельно допустимых электрических режимов эксплуатации КТ8164

Параметры	Обозначение	Ед. измер.	Значение
Напряжение коллектор- база КТ8164А КТ8164Б	$U_{к\text{б max}}$	В	700 600
Напряжение коллектор-эмиттер КТ8164А КТ8164Б	$U_{кэ max}$	В	400 300
Напряжение эмиттер-база	$U_{э\text{б max}}$	В	9
Постоянный ток коллектора	$I_{к max}$	А	4
Импульсный ток коллектора ($t_{\text{и}} \leq 5\text{ мс}, Q \geq 100$)	$I_{к и max}$	А	8
Постоянный ток базы	$I_{б max}$	А	2
Рассеиваемая мощность коллектора	$P_{к max}$	Вт	75